

国产澜起科技 DDR4 全缓冲架构纳入国际标准，正研发 DDR5 内存

来源：凤凰网

在存储芯片领域,DRAM 内存及 NAND 闪存的国产率都基本是 0,技术及产能主要掌握在三星、SK Hynix、美光、东芝等公司手中,尤其是高价值的 DRAM 内存芯片,三星、SK Hynix 及美光三家公司占了全球 95%的份额。

国内的 DRAM 内存芯片布局主要有合肥长鑫/兆易创新的内存芯片项目,福建晋华与台联电合作的内存项目由于被美国制裁而陷入了困境。除了 DRAM 芯片,国内有一些公司主攻内存接口芯片,前不久宣布津逮系列国产 X86 处理器的杭州澜起科技就是其中之一,该公司正在申请国内的科创板上市,日前在招股书中披露了他们在 DDR 内存芯片上的技术进展及布局。

澜起科技成立于 2004 年,是全球内存接口芯片的主要供应商之一,凭借领先的技术水平,在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势,其发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构,最终被 JEDEC 国际标准采纳。同时正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定,是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,并计划在未来三年完成第一代 DDR5 内存接口芯片的研发和产业化。

文章收入时间: 2019-06-06